1P017

環状炭化水素骨格を導入した新規 TTF 誘導体の合成と性質 (理研) 武藤 豪志、白旗 崇、今久保 達郎

【序】我々は、TTF 骨格に導入したヨウ素原子とヘテロ元素の間で形成される非共有結合的な分 子間相互作用(ヨウ素結合)を利用して、有機伝導体結晶の超分子構造と電子物性の制御をめざ して研究を行っている。本研究では、ヨウ素結合と相補的な手法として、ドナー分子骨格に剛直 な環状炭化水素骨格を導入することによる結晶構造制御について検討を行っている。その理由は、 剛直な環状炭化水素骨格の導入が、ドナー分子の電子的な特性を損ねることなく結晶構造制御に 寄与するのではないかと考えたからである。前述の目的のために、かさ高くほぼ球状の構造を有 する 2-アダマンチリデン(Ad)基と、対照的に平面的でコンパクトな 1-シクロブチリデン(Cb) 基を導入したドナー分子を設計し、その合成について既に報告している[2,3]。本発表では、電気 分解によって得られたカチオンラジカル塩の、単結晶構造解析および電気伝導度測定の結果を中 心に報告する。

【実験】ドナー分子の合成は、Misakiらの報告[1]を参考に、以前報告した方法で行い(スキーム 1[2,3]) 質量分析、<sup>1</sup>HNMR および元素分析により確認を行った。得られたドナー分子(3a~4d) を各種アニオンのテトラブチルアンモニウム塩を含む溶液中、定電流法によって電気分解を行う と、いくつかの組み合わせで結晶性のカチオンラジカル塩が得られた(表 1)。これらの結晶につ いて単結晶 X線構造解析と電気伝導度測定を行った。

【結果と考察】定電流電気分解に よる結晶作成では、表 1 に示した ドナー - アニオンの組み合わせで 結晶性のカチオンラジカル塩が得 られた。Cb 基を持つドナー分子 (4a-d)では 4d-Au(CN)<sub>2</sub>、および 4a-GaCl<sub>4</sub> の組み合わせにおいて、 結晶性のカチオンラジカル塩が得



られた。このうち 4a の GaCl₄<sup>-</sup>塩について構造解析を行ったところ、興味深いことに、この塩では 二分子の 4a が電気分解中に二量化反応により架橋した 1,3-ジチオリウムカチオンを形成すること がわかった(図1)。

一方、Ad 誘導体は表1に示したように正四面体、直線、平面型など様々な形状のアニオン種と カチオンラジカル塩を形成した。特にエチレンジチオ基を含む誘導体 3a は、種々の正四面体型ア ニオンとの間で金属的な伝導性を持つ平板状の単結晶を与えた。これらの塩は170~180 K 付近で 金属-絶縁体転移を示す(表1,図3)。X 線構造解析の結果から、3a-GaCl<sub>4</sub>、GaBr<sub>4</sub>、InCl<sub>4</sub>塩のド ナー - アニオン比は3:1 であることがわかった。ジヨード TTF 誘導体 3d と I<sub>3</sub>、Au(CN)<sub>2</sub>などの 直線型アニオンの形成する塩では、ドナー分子の形成する格子状のチャンネル内にアニオンある いは溶媒が一次元的に配列した特徴的な構造をとることがわかった。図2に(3d)(I<sub>3</sub>)0.59の結晶構造

表1 電気分解によるカチオンラジカル塩の作成.

を示す。チャンネル構造を持つ塩 のうち(3d)(I<sub>3</sub>)<sub>0.59</sub>は比較的高い電気 伝導率(σ<sub>rt</sub> = 15 S cm<sup>-1</sup>)を持つこ とがわかった。また、X 線構造解 析の結果から、この塩のチャンネ ル内のアニオンは孤立した I<sub>3</sub>-イオ ンではなく、ポリヨード鎖を形成 していることが明らかになった。 これらのユニークなチャンネル構 造は剛直でかさ高い環状炭化水素 基の導入による立体効果が顕著に 表れた例であると考えられる。



図 1 (4a)<sub>2</sub>GaCl<sub>4</sub>の分子構造式(A)および 4a 二量体の ORTEP 図(B).

## 表 2 (4a)<sub>2</sub>GaCl<sub>4</sub>および(3d)(I<sub>3</sub>)<sub>0.59</sub>の結晶パラメータ.

	$(4a)_2GaCl_4$	$(3d)(I_3)_{0.59}$
Empirical formula	$C_{26}H_{21}S_{16}GaCl_4$	C17H14S6I3.77
Formula weight	1057.9	889.2
Crystal system	Triclinic	Monoclinic
Space group	$P\overline{1}$ (No. 2)	$P2_1/c$ (No.14)
a ( )	9.1263(19)	18.988(4)
b ( )	12.897(3)	9.606(2)
с ( )	16.578(3)	18.084(3)
α(°)	89.001(6)	90.0
β(°)	80.550(5)	99.625(4)
γ(°)	85.870(6)	90.0
$V(^{3})$	1919.8(7)	2353.1(9)
Ζ	2	4
$R, R_{\rm w}$	0.1228, 0.2846	0.1039, 0.2805
GOF	1.028	1.025

D	А	S	D : A : S	$ ho_{\rm rt}$ / $\Omega$ cm	$T_{\rm MI}$ or $E_{\rm a}$
3a	GaCl <sub>4</sub>	$CH_2Cl_2$	$3:1^{a}$	0.05	179 K
	$GaBr_4$	$CH_2Cl_2$	$3:1^{a}$	0.14	172 K
	FeCl <sub>4</sub>	PhCl	-	0.07	177 K
	InCl <sub>4</sub>	$CH_2Cl_2$	$3:1^{a}$	0.04	179 K
3b	$BF_4$	PhCl	$1:1:1^{a}$	Ι	
	$ClO_4$	PhCl	$1:1:1^{a}$	Ι	
3d	Au(CN)2	PhCl	$1:1:1^{a}$	31	268 meV
	Au(CN)2	$CH_2Cl_2$	$2:1:1^{a}$	13 <sup>c</sup>	116 meV
	$I_3$	PhCl	$1: 0.59^{b}$	0.07	9 meV
	$Pd(CN)_4$	$CH_2Cl_2$	$2:1:1^{a}$	1750	203 meV
4a	$GaCl_4$	$CH_2Cl_2$	$2:1^{a}$	Ι	
4d	Au(CN) <sub>2</sub>	PhCl	-	0.09	205 meV

D: ドナー分子,A: アニオン,S: 溶媒,I: 絶縁体,a: 構造解析により決定
 b: 元素分析により決定,c: 結晶内の溶媒が一部除かれた試料の数値.



図 2 (3d)(I<sub>3</sub>)<sub>0.59</sub>結晶の形成するチャンネル構造.



図 3 (**3a**)<sub>3</sub>X (X = GaCl<sub>4</sub>, GaBr<sub>4</sub>) の比抵抗の 温度依存性.

## 【参考文献】

[1] Y. Misaki et al., Tetrahedron Lett., 33, 4321 (1992).

[2] 今久保、谷藤、白旗、日本化学会第 84 春季年会, 1PB-031 (2004).

[3] 武藤、白旗、今久保、日本化学会第 85 春季年会, 3G4-16 (2005).